

Было установлено, что для описания исследуемого процесса наиболее приемлема мономолекулярная РФ, т. к. в этом случае довольно низкое значение err_{av} (около $2,0 \cdot 10^{-4}$) достигается при изменении только одного подгоночного параметра τ . Что касается дробно-экспоненциальной РФ, то достаточно малые значения err не принимаются нами во внимание по двум причинам: во-первых, данная РФ хорошо описывает почти все деградиационные процессы в топологически разупорядоченных твердых телах и, во-вторых, она содержит дополнительный подгоночный параметр r .

Таким образом, мы получили еще одно дополнительное подтверждение природы электронно-индуцируемого дихроизма в исследованных халькогенидных стеклообразных полупроводниках. Так как топологические дефекты, вызывающие эффект ЭИД в ХСП, являются парами некоординированных атомов типа (As_2^+, S_1^-) , (As_2^-, As_2^+) и (S_1^-, S_1^+) , их аннигиляция связана, очевидно, с восстановлением разорванных химических связей. Этот процесс характеризуется преимущественно одним значением энергии активации вследствие доминирования концентрации гетерополярных ковалентных связей As—S, вызывающих эффект ЭИД.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Вакив Н. М., Балицкая В. А., Шпотюк О. И., Буткевич Б. Деградиационные превращения в топологически разупорядочен-

ных твердых телах: 1. Математические модели кинетики // Технология и конструирование в электронной аппаратуре.— 2003.— № 4.— С. 61—64.

2. Shhpotyuk O. I., Balitska V. O. Electron-induced dichroism in vitreous As_2S_3 : physical features and microstructural mechanism // Physica Status Solidi.— 1998.— Vol. 165.— P. 295—302.

3. Шпотюк О. И., Балицкая В. А. Физические особенности электронно-индуцированного дихроизма в стеклообразном трисульфиде мышьяка // Физика твердого тела.— 1998.— Т. 40, № 1.— С. 52—56.

4. Пикаев А. К. Современная радиационная химия. Основные положения. Экспериментальная техника.— М.: Наука.— 1985.

5. Любин В. М., Тихомиров В. К. Фотоиндуцируемый дихроизм в пленках халькогенидных стеклообразных полупроводников // Физика твердого тела.— 1991.— Т. 32, № 6.— С. 1838—1844.

6. Матковский А. О., Убизский С. Б., Шпотюк О. И. Роль атомных смещений в радиационно-стимулированных превращениях халькогенидных стеклообразных полупроводников // Там же.— 1990.— Т. 32, № 6.— С. 1790—1794.

7. Фельц А. Аморфные и стеклообразные неорганические материалы.— М.: Мир, 1986.

8. Клиггер М. И., Лущик Ч. Б., Машовец Т. Б. и др. Создание дефектов в твердых телах // Успехи физических наук.— 1985.— Т. 147, № 3.— С. 523—558.

9. Шпотюк О. Й. Вплив гамма-опромінення на спектри оптичного пропускання і мікротвердість склоподібного As_2S_3 — Sb_2S_3 // Вісник Львівського ун-ту: Проблеми фізики твердого тіла.— 1985.— Вип. 19.— С. 25—31.

в портфеле редакции в портфеле редакции в портфеле редакции в портфеле редакции

- Коррекция "силового" размещения компонентов. П. И. Дмитриев, С. В. Зудин, М. С. Лузин, О. Б. Полукасасов (Россия, г. С.-Петербург)
- Метод контроля процессов формирования и набора прочности вяжущих сред. Л. М. Зайченко, А. И. Сердюк, В. Д. Фотий, Ю. Ф. Шевчук (Украина, г. Черновцы)
- Инфракрасное излучение полупроводников как экспресс-метод контроля качества полупроводниковых диодов. С. П. Павлюк, Л. В. Ищук, В. М. Кислицын (Украина, г. Киев)
- Система экологического мониторинга степени загрязнения воздуха автомагистралей населенных пунктов выбросами автомобильного транспорта. Г. А. Девятко, С. А. Лацис, В. Я. Подольский, В. В. Закрасняный (Украина, г. Киев)
- Термоэлектрические свойства сплавов системы $TlInTe_2$ — $TlYbTe_2$. М. М. Зарбалиев, Н. Ф. Гахраманов, Н. С. Сардарова, Г. А. Гейдарова (Азербайджан, г. Сумгаит)
- Выбор полупроводникового материала для детекторов гамма-излучения. А. С. Абызов, В. М. Ажажа, Л. Н. Давыдов, Г. П. Ковтун, В. Е. Кутний, А. В. Рыбка (Украина, г. Харьков)
- Модернизация системы линейной телемеханики "Хортица". С. В. Дубец, Е. Н. Федорченко, В. И. Кузьминов (Украина, г. Запорожье)
- Закономерности деградации светоизлучающих диодов. И. М. Викулин, В. И. Ирха, Б. В. Коробицын, В. Э. Горбачев (Украина, г. Одесса)
- О сбережении окружающей среды в гальванотехнологии. М. Д. Скубилин, А. В. Письменов, Б. А. Гусев (Россия, г. Таганрог)
- Исследование возможности использования фотоприемных устройств в качестве контрольных. Б. М. Ницович, И. В. Докторович, В. Н. Годованюк, В. К. Бутенко, В. Г. Юрьев (Украина, г. Черновцы)
- Деградиационные превращения в топологически разупорядоченных твердых телах: 3. Композиционные особенности бимолекулярной кинетики затухания радиационно-оптических свойств халькогенидных стекол. Н. М. Вакив (Украина, г. Львов)



- Метод проектирования топологии тонкопленочной микросборки. В. Г. Спирин (Россия, г. Арзамас)
- Выявление скрытых резервов производства методами пассивного статистического моделирования. Ю. А. Долгов (Молдова, г. Тирасполь)
- Разработка базы знаний для диагностики РЭА на основе метода эвристической классификации. В. Е. Трофимов (Украина, г. Одесса)

в портфеле редакции в портфеле редакции в портфеле редакции в портфеле редакции